

第174回 研究集会 詳細

1. 日時 : 2014年7月4日(金) 10:00-16:30
2. 場所 : 機械振興会館 B2 研修1号室
(〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 <http://www.jspmi.or.jp/about/access.html>)
3. オーガナイザー : 廣木 彰 <京都工芸繊維大学>
4. 担当 : 林 洋一 <ラピスセミコンダクタ>
5. テーマ : 新材料系デバイスのモデリング技術
6. 参加費 : 分科会員 2000円、非分科会員 4000円

プログラム

0. モデリング研究委員会から 10:00-10:05
廣木 彰 <モデリング研究委員会>

座長 小田嘉則 <STARC >

1. [招待講演] 自己無撞着 GW 近似法の半導体などへの応用 ; バンド構造や衝突イオン化率等の計算
小谷岳生 10:05-10:55
<鳥取大学工学部 応用数理工学>
2. [招待講演] グラフェンの電子物性におけるナノスケール・エッジ効果の理論 10:55-11:45
若林克法
<(独) 物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点>

昼食 11:45-13:00

座長 宇野重康 <立命館大学>

3. シリセン/ゲルマネン/グラフェン FET の電子輸送モデリング-(仮)- 13:00-13:40
土屋英昭、兼古志郎、平井秀樹、森規泰
<神戸大学大学院工学研究科 電気電子工学専攻>
4. 量子エネルギー輸送モデルを用いた Si, Ge, III-V n-MOSFET の短チャネル効果の解析
鍾 菁廣 1、小田中 紳二 1、廣木 彰 2 13:40-14:20
<1 大阪大学サイバーメディアセンター, 2 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科>

休憩

座長 山川真弥 <ソニー株式会社>

5. 半導体/バイオインターフェイス構造の分子動力学法による解明 14:30-15:10
前川侑毅、澁田靖、坂田利弥
<東京大学大学院工学系研究科>
6. 新材料系デバイス回路混合解析 15:10-15:50
松澤 一也、小田 嘉則、小町 潤、伊藤 浩之、石川 清志
<(株)半導体理工学研究センター>
7. SiC デバイスシミュレーションと第一原理計算技術 15:50-16:30
(1) デバイスシミュレーション技術、(2) 第一原理計算
(1) 山口 憲、桑原 匠史、(2) 加藤信彦、西原慧径、岡崎一行
<アドバンスソフト株式会社>

以上